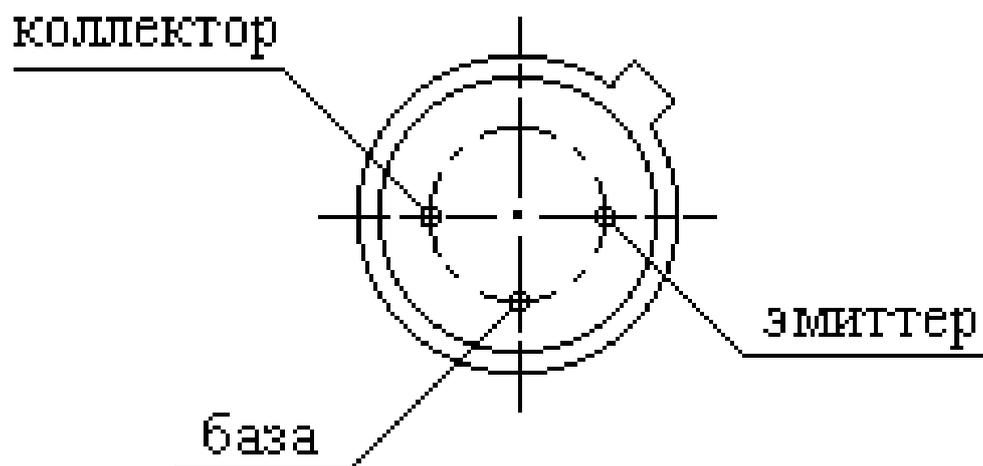


ТРАНЗИСТОРЫ 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В

Кремниевые планарно-эпитаксиальные n-p-n – транзисторы 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в усилительных схемах.

Схема расположения выводов



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при $t = (25 \pm 10) \text{ }^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма	
	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($U_{кб} = 1 \text{ В}, I_{к} = 10 \text{ мА}$)		
2Т325А	30	90
2Т325Б	70	240
2Т325В	160	400
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{кб} = 15 \text{ В}$)	-	0,5
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{эб} = 3 \text{ В}$)	-	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{кб} = 5 \text{ В}, I_{э} = 10 \text{ мА}, f = 10^8 \text{ Гц}$)		
2Т325А, 2Т325Б	8	-
2Т325В	10	-
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс ($U_{кб} = 5 \text{ В}, I_{э} = 10 \text{ мА}, f = 3 \cdot 10^7 \text{ Гц}$)	-	125 2
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{кб} = 5 \text{ В}, f = 10^7 \text{ Гц}$)	-	2,5
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{кб} = 1 \text{ В}, f = 10^7 \text{ Гц}$)	-	2,5
Граничное напряжение, В ($I_{к} = 10 \text{ мА}$)	15	-